PRECISE RF CONTROL SYSTEM OF THE SCSS TEST ACCELERATOR

Hirokazu Maesaka^{1,A)}, Takashi Ohshima^{A)}, Naoyasu Hosoda^{A)}, Toru Fukui^{A)}, Takahiro Inagaki^{A)}, Sunao Takahashi^{B)},

Teruaki Hasegawa^{B)}, Shin-ichiro Tanaka^{B)}, Masanobu Kitamura^{C)}, Yuji Otake^{A)} and Hitoshi Tanaka^{A)}

A) RIKEN, XFEL Joint Project / SPring-8

1-1-1 Kouto, Sayo-cho, Sayo-gun, Hyogo, 679-5148, Japan

^{B)} JASRI, XFEL Joint Project / SPring-8

1-1-1 Kouto, Sayo-cho, Sayo-gun, Hyogo, 679-5198, Japan

^(C) Nichizou Electronic Control Corporation

5-3-28 Nishi-kujo, Konohana-ku, Osaka-shi, Osaka, 554-0012, Japan

Abstract

We present development and performance of the low-level rf control system of the SCSS test accelerator. The low-level rf system consists of IQ modulators / demodulators and VME waveform generators / digitizers. Recent improvements of them established high-resolution phase and amplitude setting capabilities of 0.01 degree and 0.01%, respectively. In addition, temperature drifts of the injector acceleration cavities were reduced by tuning a precise temperature regulation system. The temperature fluctuation was improved to be 0.01 K rms. As a result, the rf phase and amplitude stabilities of sub-harmonic buncher cavities were achieved to be 0.02 degree rms and 0.03% rms, respectively. The saturated FEL radiation in the wavelength region of 50–60 nm is stably generated by this improvement.

SCSS試験加速器のRFシステムの高精度化

1. はじめに

X線自由電子レーザー(XFEL)の試作機として作ら れたSCSS試験加速器が運転されており、真空紫外線 領域のFEL光がさまざまな実験に利用されている。 一般に短波長のSASE (Self-Amplified Spontaneous Emission) FELでは高いピーク電流(>1kA)で低エミッ タンス(~1π mm mrad)なビームが必要である。その ような高品質電子ビームを安定に生成するには加速 RFの位相や振幅を精密に制御しなければならない。 われわれのシステムでは熱電子銃からの約1Aのビー ムをサブハーモニックバンチャによる速度変調バン チングと磁場シケインによるバンチ圧縮をすること により数kAのピーク電流を得なければならない。こ のようにバンチ圧縮率が非常に高いため、サブハー モニックバンチャ空胴やシケイン上流の加速管に蓄 積されたRFの位相・振幅が少しでもずれるとすぐに ピーク電流が下がったりエミッタンスが悪化したり して,安定なFEL光が得られない。シミュレーショ ンによると位相の許容差は時間にして100fs以下であ る。これは238MHzバンチャ空胴の位相で0.01度, 5712MHz主加速管の位相で0.2度に相当する。SCSS 試験加速器の建設時はまだこれを満足する技術が確 立していなかったため許容差を1ps未満に設定して デザインをおこなった。しかし、この性能では真空 紫外線FELの増幅を観測できたが飽和を達成するこ とができなかった。そこで、われわれはRFの設定・ 検出分解能を上げたり,空胴の温度安定度を改善し たりして加速RFの安定化をおこなった。本稿ではこ れらの改良点とその性能について述べる。

2. RFシステム

SCSS試験加速器のRFシステムのブロック図を図1 に示す。マスターオシレータから位相ノイズの小さ い基準RF信号が配られる。IQ (In-phase and Quadrature-phase) 変調器[2]を使って基準RF信号から しかるべき位相・振幅をもったパルスRF信号を生成 する。IQ変調器に供給するベースバンド信号の波形 はVME高速D/A変換ボード[3]から出力する。得られ たパルスRF信号は半導体増幅器, IOT, クライスト ロンなどで大電力に増幅されて加速空胴に印加され る。加速空胴のRFのごく一部はとりだされてIQ復調 器[2]で検波される。IQ復調器からのベースバンド信 号の波形はVME高速A/D変換ボードに記録される。 また、空胴の共振周波数を安定化するため、精密温 度調節装置[4]を備えている。さらに、空胴内のRF の位相・振幅を安定化させるためPIDフィードバッ クプログラムを使って制御している。以下,各機器 の内容について詳しく述べる。

2.1 IQ変調器・復調器

IQ変調器は *I(t)*, *Q(t)* のふたつのベースバンド 信号を受けて以下の式で表わされるような出力RF *V(t)* を生成する。

 $V(t) = I(t)\cos(\omega t) + Q(t)\sin(\omega t)$, (1) ここに、 ω は搬送波の角周波数である。これにより、 任意の位相・振幅波形をもったRF信号を作り出すこ とができる。逆に、IQ復調器は入力RF信号から位 相・振幅波形をとりだす回路である。変復調器とし ては、RFミキサと90度位相差のあるパワーディバイ ダがひとつのICチップに内蔵されたものを使用して

¹ E-mail: <u>maesaka@spring8.or.jp</u>



図1: RFシステムのブロック図

いる。このIQ変復調器の位相の誤差は±0.5度,振幅 誤差は±数%である[2]。この回路は0.1 K以内に制御 されたヒータの上に実装して温度変動を防いでいる。

2.2 VME高速D/A・A/D変換ボード

われわれの使用するVME高速D/A・A/D変換ボード[3]はいずれも12ビット分解能で、位相分解能は 0.03度相当、振幅分解能はフルスケールに対して 0.05%に相当する。サンプリング周波数は238MHzで ある。D/Aボードに関してはボード上のD/A変換 チップ自体は14ビット分解能を持っているが、開発 当時はA/Dボードに合わせるためにファームウェア で12ビットに下げていた。これは後述するように、 今回の改良で14ビット分解能が出せるようにした。

2.3 精密温度調節装置

加速空胴の温度が変化すると、共振周波数が変化 して空胴内のRFの位相が変わってしまう。共振周波 数が f_0 から $f_0 + \Delta f$ に変化すると、空胴内のRF位 相の変化 $\Delta \varphi$ は以下の式のように書ける。

$$\Delta \varphi = 2Q_L \cdot \frac{\Delta f}{\epsilon} \quad \text{[rad.]},\tag{2}$$

ここに、 Q_L は空胴の負荷Q値で、10000程度の値で ある。一般に $\Delta f/f_0$ は銅の熱膨張係数から17ppm/K であるので、RF位相は10度/Kのオーダーで変化する ことになる。位相変動を0.1度に抑えるには温度変動 は0.01Kにしなければならない。施設からの冷却水 の温度安定度は±0.1Kと安定度が不十分なため、精 密温度調節装置 [4]を導入した。このブロック図は 図1に描かれている。本システムは空胴の冷却水を ヒータで温め、空胴の温度が一定になるようにヒー タの出力を制御する。温度計として白金測温抵抗体 が水配管や空胴胴体に取り付けられている。制御 シーケンスはPLC上に実装されている。

3. 改善点とその性能

SCSS試験加速器の初期の調整のときのRF位相・ 振幅精度では、FEL増幅を観測することはできたが 飽和を達成することができなかった。そこで、RFシ ステムの精度と安定度を上げるべく、精密温度調節 装置の改良、PIDフィードバックプログラムの導入、 D/A・A/Dボードの分解能向上を試みた。

3.1 精密温度調節装置の改良

調整初期のころ,空胴温度は0.1K以内に安定化さ れているにもかかわらず, RF位相の変動によるビー ムの不安定性があった。原因を調べると、わずかに 空胴温度がハンチングしていることがわかった。こ のハンチングは空胴の熱容量が大きいことによる位 相遅れが原因であることがわかった。そこで、制御 用の温度測定点を空胴胴体からヒータ直後の水の温 度に変えた。この場合、制御ループ内の位相遅れは 小さくなるが空胴の温度はループ外に出てしまう。 しかし、空胴の熱容量が大きいおかげで外からの熱 流入に対する温度変動が小さく、また、温度変動が 起きる前に冷却水がその熱を取り除くので、環境温 度などが変わっても影響を小さくなっていると考え ている。さらに、制御パラメータの微調整や温度計 データ収集部にディジタルローパスフィルタを導入 するなどして精度を上げた。改良後の温度のトレン ドグラフを図2に示す。施設から供給される冷却水 の温度変動が0.2K程度あるのに対して、空胴胴体の 温度は±0.02K以内に安定化されている。温度計の 分解能が0.01Kなのでほとんど測定限界である。



3.2 PIDフィードバックプログラム

加速RFの位相・振幅を安定化させるため,IQ復調器で検波した加速RFが一定になるようにIQ変調器に PIDアルゴリズムでフィードバックするプログラム を開発した。いまのところ更新周期は1秒で,0.1Hz 以下の変動について安定化させることができている。 このプログラムにより,D/A・A/Dボードの分解能 (12ビット)に匹敵するところまで安定化することが でき,FEL増幅の観測に至った。しかし,D/Aボー ドの設定値とFEL光の強度に相関がみられ,D/A ボードの最小ビットの変化でもFEL光の強度に影響 することがわかった。したがって,D/A・A/Dボー ドの分解能向上が必要となった。

3.3 RF位相・振幅の設定・検出分解能の向上

まず,D/Aボードにはもともと14ビットのD/A チップが実装されているので、ファームウェアを改 良するのがひとつの方法である。しかし、ファーム ウェアの変更には時間と労力がかかるため、当面の 措置として波形を工夫して擬似的に分解能を上げる こととし、その効果を確かめたうえでファームウェ アの変更をすることにした。波形の工夫というのは, 波形のフラットなところで最小ビットを数クロック ごとに上げたり下げたりするディザ処理[5]をおこ なって最小ビット以下の分解能を得るというもので ある。たとえば、最小ビットの1/4の値を得るには全 クロックの25%で最小ビットを1にし,残り75%で0 にすればよい。この処理をすると高周波のノイズが 出るが、ボード上のローパスフィルタや加速空胴の 狭いバンド幅のおかげで影響はほとんどない。この 方法を適用した結果、約2ビット相当の分解能向上 効果がみられ、位相・振幅分解能はそれぞれ0.01度、 0.01%が得られた。この数カ月後、ファームウェア の改良で14ビット分解能がえられるようにしたが, 同様の性能が得られることを確認した。

次に、A/Dボードの分解能強化について述べる。 こちらはデータ収集時に複数ショットの平均値を得 ることで擬似的に実現した。このときの運転繰り返 しは10 ppsであったが、RFのフィードバックプログ ラムは1秒周期だったので、A/Dボードのデータを10 ショット平均したものを使うことにした。これによ り、ランダムノイズが1/√10 に減ることが期待され る。これは1.7ビットの分解能向上に相当する。

これらの改善をおこなった結果,たとえば 238MHz空胴内のRFの位相・振幅は図3に示すトレン ドグラフのようになった。位相安定度は0.02度RMS, 振幅安定度は0.03% RMSという値が得られた。

3.4 FELの性能

以上に述べたようなRFシステムと精密温度調節装置の改善をおこなった結果,加速器の調整が効率的に進められ,2007年秋に波長50~60nmのFELの飽和を達成した[1]。FELが飽和しているときのFEL強度のトレンドグラフを図4に示す。強度はPINフォトダイオードにて測定した。強度のゆらぎの幅のRMS値は約10%で,FEL飽和時の予想値と一致する。FELの飽和状態は10時間以上持続可能で,ユーザ運転に十分利用可能である。

4. まとめ

短波長のSASE-FELには高精度かつ安定なRFシス



図3: 238MHz空胴のRFの位相(a)と振幅(b)のトレ ンドグラフ。赤線がIQ復調器の検出値で,青線 がIQ変調器の設定値である。



テムが必要である。SCSS試験加速器では,IQ変復 調器やVME高速D/A・A/DボードでRFの制御をおこ ない,精密温度調整システムで空胴温度を安定化し ている。RF位相・振幅の設定・検出分解能向上, フィードバックプログラムの導入,精密温度調節装 置の改善により,サブハーモニック空胴内のRFの位 相安定度0.02度RMS,振幅安定度0.03% RMSを実現 した。これにより,加速器の調整が効率的に進み, 波長50~60nmのFELの飽和を達成することができた。

参考文献

- [1] H. Tanaka et al., "Operation Status of the SCSS Test Accelerator", proc. of EPAC'08.
- [2] Y. Otake et al., "SCSS RF Control Toward 5712MHz Phase Accuracy of One Degree", proc. of APAC'07.
- [3] T. Fukui et al., "A Development of High-speed A/D and D/A VME Boards for a Low Level RF System of SCSS", proc. of 10th ICALEPCS conf. (2005).
- [4] S. Takahashi et al., "Precise Temperature Regulation System for C-band Accelerating Structure", proc. of APAC'04.
- [5] B. Widrow and I. Kollár, "Quantization Noise: Round-off Error in Digital Computation, Signal Processing, Control, and Communications", 685–695, Cambridge University Press (2008).